

プレスリリース

## X-FAB 180nm 高耐圧 CMOS プロセスに車載向け組込フラッシュメモリを追加

2021 年 4 月 14 日、ベルギー、テッセンデルロ発

アナログ-ミックスドシグナルおよび特徴的な半導体ソリューションで世界を牽引するファウンダリ X-FAB Silicon Foundries は本日、車載向け高耐圧プロセス XP018 における新たなフラッシュメモリの提供を発表しました。この新たなフラッシュ IP は X-FAB において既に広く実績のある Silicon Oxide Nitride Oxide Silicon (SONOS) 技術を活用し、高性能と業界屈指の信頼性の両方を併せ持つものです。車載規格 AEC-Q100 グレードに準拠し、-40°Cから 175°Cの動作温度および ISO26262 規定の機能安全にも完全に対応します。

メモリサイズは 32 Kbyte で、32-bit のデータバスを持つ 8K x 39-bit の構成となっています。残りの 7bit はエラー訂正 (ECC) に割り当てられ、市場におけるゼロディフェクトを確かなものにします。組み込み不揮発性メモリ (NVM) IP テストインターフェース (XSTI) も提供され、メモリへの完全なシリアルアクセスを可能とします。

この車載グレードのフラッシュ IP は 1.8V 単独電源で動作し低電力デザインに最適です。自己診断 (BIST) モジュールを追加することで、効果的なメモリテストのみならず包括的なデバッグが可能となります。必要に応じ不揮発性メモリのテストサポートも対応可能です。

X-FAB の不揮発性メモリ開発責任者の Thomas Ramsch は次のように述べています。「この新たな IP ソリューションは、幅広い電源電圧およびウェハ素材を選択いただける 180nm プロセスプラットフォームに対し、組込フラッシュのポートフォリオを更に充実させるものです。これにより、様々なアプリケーションにおけるお客様要求に応えます。とりわけ、低電力と厳しい環境での動作が求められる場合に、更に価値あるものとなります。」



X-FAB の不揮発性メモリ テクノロジーマーケティングマネージャーの Nando Basile は次のようにも述べています。「新たな組込フラッシュ技術で X-FAB の既存プラットフォームが補完されることで、フットプリントの削減が可能となります。また、XP018 のモジュール式アプローチによりマスクレイヤ数の削減も可能です。これらによりチップコストの大幅な削減が可能となります。このフラッシュ IP を加えることにより XP018 は、更に大規模なロジックや高い演算能力が求められるミックスドシグナルや高耐圧アプリケーションに対しても費用対効果の高いソリューションを提供できるようになります。これはとりわけ、ヘルスケア、産業用途、民生用途や IoT といった分野で多大な可能性を有するポータブルやスマートセンサ等の電池式デバイスに恩恵をもたらします。」

###

## X-FAB について

X-FAB はアナログ-ミックスドシグナルと MEMS で世界をリードするファウンダリグループで、車載・産業・民生・医療・その他用途向けのシリコンウェハを製造しています。1.0~0.13 ミクロンの CMOS・SOI プロセス、特別な SiC・MEMS の長寿命プロセスで、世界中のお客様に、最高レベルの信頼性、卓越した製造技術、革新的なソリューションを提供しています。X-FAB のアナログ-デジタル集積回路(ミックスドシグナル IC)・センサ・micro-electro-mechanical systems (MEMS) は、ドイツ・フランス・マレーシア・アメリカの 6 つの工場で製造されており、従業員は全世界で 3,800 名です。詳しい情報は、[www.xfab.com](http://www.xfab.com) をご覧ください。

## X-FAB プレスお問合せ先

Thomas Hartung  
VP Sales & Corporate Marketing  
X-FAB Silicon Foundries  
+49-361-427-6160  
[thomas.hartung@xfab.com](mailto:thomas.hartung@xfab.com)

## 略語

BIST	Built-in-Self-Test
ECC	Error Code Correction
IP	Intellectual Property
NVM	Non-Volatile Memory
SONOS	Silicon Oxide Nitride Oxide Silicon